

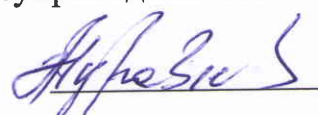
634050, г. Томск, пр. Ленина, 40,
Томский государственный
университет систем управления и
радиоэлектроники.

Председателю диссертационного
совета 212.268.04 на базе Томского
государственного университета систем
управления и радиоэлектроники, д.т.н.,
профессору Шандарову С.М.

Уважаемый Станислав Михайлович!

Подтверждаю свое согласие на назначение официальным оппонентом
по диссертации Сима Павла Евгеньевича «Исследование омических
контактов НЕМТ транзисторов на основе GaN» по специальности 01.04.04 –
«Физическая электроника, технические науки» на соискание ученой степени
кандидата технических наук. Сведения, необходимые для размещения на
сайте ТУСУР, прилагаются.

д.ф.-м.н., заведующий лабораторией
молекулярно-лучевой эпитаксии
полупроводниковых соединений A_3B_5

 ИФП СО РАН
К.С. Журавлев

Подпись К.С.Журавлева заверяю
ученый секретарь ИФП СО РАН
к.ф.-м.н.



С.А. Аржанникова

Сведения об официальном оппоненте

по диссертации Сима Павла Евгеньевича «Исследование омических контактов НЕМТ транзисторов на основе GaN» по специальности 01.04.04 – «Физическая электроника» на соискание ученой степени кандидата технических наук.

Фамилия, имя, отчество	Журавлев Константин Сергеевич,
Гражданство	Российская Федерация
Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация)	доктор физико-математических наук 01.04.10 -«физика полупроводников»
Ученое звание (по кафедре, специальности)	
Основное место работы	
Должность	заведующий лабораторией
Наименование подразделения (кафедра, лаборатория)	Лаборатория молекулярно-лучевой эпитаксии полупроводниковых соединений AzB_5
Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук
Почтовый индекс, адрес, веб-сайт, телефон, адрес электронной почты организации	630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, пр. ак. Лаврентьева, д. 13 http://www.isp.nsc.ru/ +7(383)330-90-55 http://www.isp.nsc.ru/institut/kontakty-i-rekvizity
Публикации по специальности 01.04.10 – «Физика полупроводников» (4-5 за последние 5 лет, в том числе обязательно указание публикаций за последние три года)	
1. G.Atmaca, P.Narin, E.Kutlu, T.Malin, V.G.Mansurov, K.S.Zhuravlev, S.B.Lisesivdin. Negative Differential Resistance Observation and a New Fitting Model for Electron Drift Velocity in GaN-based Heterostructures. IEEE Transactions on Electron Devices, 2018, Volume: 65, Issue:3, Page(s): 950-956. 10.1109/TED.2018.2796501.	
2. Д.Ю.Протасов, А.К.Бакаров, А.И.Торопов, Б.Я.Бер, Д.Ю.Казанцев, К.С.Журавлев. Подвижность двумерного электронного газа в DA-pHEMT гетроструктурах с различной шириной профиля d-n-слоев. Физика и техника полупроводников, 2018, т. 31, № 03. С. 172–176.	

3. D.Yu.Protasov, K.S.Zhuravlev. The Influence of Impurity Profiles on Mobility of Two-Dimensional Electron Gas in AlGaAs/InGaAs/GaAs Heterostructures Modulation-Doped by Donors and Acceptors. Solid State Electronics, 2017, 129, 66–72; <http://dx.doi.org/10.1016/j.sse.2016.12.013>.
4. Gökhan Atmaca, Sukru Ardali, Engin Tiras, Timur Malin, Vladimir G Mansurov, Konstantin S Zhuravlev, Sefer B Lisesivdin. Scattering Analysis of 2DEG Mobility in Undoped and Doped AlGaN/AlN/GaN Heterostructures with an in situ Si₃N₄ Passivation Layer. Solid State Electronics, 2016, Volume 118, April 2016, Pages 12-17, doi: 10.1016/j.sse.2016.01.006.
5. К.С.Журавлев, Т.В.Малин, В.Г.Мансуров, О.Е.Терещенко, К.К. Абгарян, Д.Л.Ревизников, В.Е.Земляков, В.И.Егоркин, Я.М.Парнес, В.Г.Тихомиров, И.П.Просвирин. AlN/GaN-гетероструктуры для нормально закрытых транзисторов. Физика и техника полупроводников, 2017, том 51, вып. 3, с.395.
6. А.А.Борисов, К.С.Журавлев, С.С.Зырин, В.Г.Лапин, В.М.Лукашин, А.А.Маковецкая, В.И.Новоселец, А.Б.Пашковский, А.И.Торопов, Н.Д.Урсуляк, С.В.Щербаков. Исследование средней дрейфовой скорости электронов в р-HEMT транзисторах. Письма в журнал технической физики, 2016, том 42, вып.16, стр. 41-47.

Официальный оппонент



К.С. Журавлев

Верно

Ученый секретарь ИФП СО АН



С.А.Аржанникова

